

Elektrische Werte der Germaniumtransistoren vom Werk für Bauelemente „Carl von Ossietzky“

Typ	Verwendungs- zweck	Emitterspannung U_E in V		Emitterstrom I_E in mA		Kollektorspannung U_C in V		Kollektorstrom I_C in mA		Kollektorverlustleistung N_V in mW		Spannungsverstärkung β		Leistungsverstärkung γ in db		Kurzschlußstabilität δ		Grenzfrequenz MHz	Eingangswiderstand R_e in Ω		Ausgangswiderstand R_a in k Ω		zulässige Außentemperatur t_c °C		Schüttelfestigkeit g	
		mittel		mittel	max.	mittel	max.	mittel	max.		max.	mittel	max.	mittel	max.	mittel	max.		mittel	max.	mittel	max.	mittel	max.		
1 NC-010	Verstärkertransistor γ max. = 17 db	bis 1 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	50	85	15	17	0,5	0,7	IV 1	200		10			+40	30	
1 NC-011		bis 3 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	50	85	15	17	0,5	0,7	IV 3	200		10			+40	30	
1 NC-012		bis 6 MHz	0,1	1	5	-15	-50	-3	-5		100	50	85	15	17	0,5	0,7	IV 6	200		10			+40	30	
1 NC-020	Verstärkertransistor γ max. = 20 db	bis 1 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	70	120	19	20	0,5	0,7	IV 1	200		10			+40	30	
1 NC-021		bis 3 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	70	120	19	20	0,5	0,7	IV 3	200		10			+40	30	
1 NC-022		bis 6 MHz	0,1	1	5	-15	-50	-3	-5		100	70	120	19	20	0,5	0,7	IV 6	200		10			+40	30	
2 NC-010	Schalttransistor		0,2	1	5	-15	-50	-3	-8		150		40	11	13	0,4	0,6		200		10			+40	30	
3 NC-010	Oszillatortransistor		0,1	1	5	-15	-50	-2	-4		120	70	120	18	20	0,8	0,9	IV 10	200		10			+40	30	